

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)										外 形	備 考	
				V _{CEO} (V)	V _{ESD} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CE} (V)	直 流 又 は パ ル ス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{FE}	h _{ie}	h _{ie} *	h _{FE} *			h _{FE} *
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10		11	12

- 1** TYPE NUMBER
- 2** ORIGINAL MANUFACTURER
- 3** USES
- 4** MATERIAL AND STRUCTURE
- 5** MAXIMUM RATINGS
- 6** I_{CEO} MAXIMUM VALUE AND V_{CE} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CEO})
- 7** STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8** STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CE}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- 9** f_{αb} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.
- 10** C_{ob} AND r_{bb'} OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN r_{bb'} COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11** OUTLINE
- 12** REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)														外形	備考
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)			
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)								h _{fb} *		
2SC828A	松下	RF. AF	Si. EP	45	5	50	250	125	1	10	65~700	5	2	5	-2	220	3600	0.4	20	220*	2.2	70	138	2SC564A とコンプリ
" 829	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	5	30	250	125	1	10	40~500	10	1	10	-1	130				230*	1.3	35	138	
★ " 830	日立	PA	Si. T	100	4	3 A	25 W (T _c =25°C)	150	100	20	30~200	4	1 A	4	-1 A					6*	120		153	2SB551 とコンプリ
" 831	日電	PA	Si. E	50	4	2 A	23 W (T _c =25°C)	175	5	20	15~200	10	1 A	10	-30	80	P _o = 12 W (V _{ce} = 18 V, P _i = 2 W, f = 260 Mc)			500*	18		111	
" 832																								
" 833	日立 東芝 三洋	SW	Si. TMe	450	6	2 A	25 W (T _c =25°C)	150	100	200	80	10	100	10	-100	100	t _{on} < 2 μS, t _{off} < 3 μS t _{exp} < 4 μS				50		99	
" 834																								
" 835																								
★ " 836	日電	RF	Si	30	4	20	200	125	0.2	20	70	10	4	10	-4	60				600*	0.9	C _c r _{bb} 3 pS	138	フイワード AGC
★ " 837	"	"	Si. E	30	4	20	250	125	0.2	20	40	10	10	10	-10	30	PG = 20 dB (f = 45 Mc)			550*	1.6		138	
★ " 838	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	-1	90				250*	1.8	C _c r _{bb} 20 pS	138	
★ " 839	"	"	"	50	5	50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	-1	90	NL = 2.5 dB (f = 1 Mc)			250*	2	C _c r _{bb} 25 pS	138	
★ " 840	松下	PA	Si. TMe	100	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60				50*	90	25	99	
★ " 840A	"	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	150	5	2 A	20 W (T _c =25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60				50*	90	25	99	
★ " 841	富士通	PA	"	36		500	6 W (T _c =25°C)	175	5	12	50	4	500	12	-150					450*	12	12*	84 B	
★ " 842	"	"	"	36		1 A	10 W (T _c =25°C)	175	5	12	40	4	1 A	12	-150					450*	13	10*	111	
★ " 843	"	"	"	36		2 A	20 W (T _c =25°C)	175	12	12	50	4	2 A	12	-150					350*	25	7*	111	
★ " 844	"	"	"	40	2	400	3.5 W (T _c =25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.1 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)			800*	3	20*	84 B	
★ " 845	"	"	"	55	3.5	400	3.5 W (T _c =25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.4 W (f = 100 Mc, V _{CE} = 28 V)			800*	3	20*	84 B	
" 846																								
" 847	富士通	RF	Si. EP	30	5	200	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1					70*	10	40	49 C	
" 848	"	RF. LN	"	30	5	200	350	175	0.1	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	60*	10	40	49 C	
" 849	"	SW. AF	"	30	5	300	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	t _r < 0.08 μS, t _f < 0.15 μS t _{sig} < 0.8 μS			49 C	
" 850	"	SW. PA	"	50	7	500	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1		t _r < 0.08 μS, t _f < 0.15 μS t _{sig} < 0.8 μS			70*			49 C	
★ " 851	日電	PA	Si. E	50	5	8 A	75 W (T _c =25°C)	200	500	30	50	5	5 A				P _o = 40 W (f = 50 Mc, V _{ce} = 13.5 V, P _i = 6 W)						102A	
" 852	"	RF	"	45	3	80	500	150	0.5	15	100	6	20	6	-20					1100*	2	C _c r _{bb} 3.7 pS	85 B	
★ " 853	日電	RF. PA	"	70	5	200	400	125	0.1	60	70	2	150	10	-10	110				90*	7.5	40*	44	2SA545 とコンプリ
★ " 854	富士通	PA	Si. EP	40	2	300	2.5 W (T _c =25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.75 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)			800*	2.5	20*	84 B	
★ " 855	"	"	"	40	2	400	3 W (T _c =25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.9 W (f = 175 Mc, V _{CE} = 12 V)			800*	2.5	20*	84 B	
★ " 856	日立	RF	Si. TPa	150	5	50	300	175		20	50	6	10	6	-10					150*	2.5	25*	12A	